









	<h2 style="color: red;">JAN1N5809US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5809US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 6A B-MELF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5809US.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5809US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 6A B-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	6A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

JAN1N5809US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5809US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5809US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5809US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5811US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 6A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5814 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 20A DO203AA</p>	 <p>JAN1N5811URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG</p>	 <p>JAN1N5807US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 6A B-MELF</p>
 <p>JAN1N5809URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG</p>	 <p>JAN1N5807 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 6A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5814 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 20A DO203AA</p>	 <p>JAN1N5809 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 6A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5809US Microsemi	JAN1N5809US Datenblatt	JAN1N5809US-Datenblätter	JAN1N5809US PDF	Microsemi JAN1N5809US
JAN1N5809US Electronic	JAN1N5809US-Komponenten	JAN1N5809US-Verteiler	JAN1N5809US-Bild	JAN1N5809US-Teil
JAN1N5809US Preis	JAN1N5809US Hersteller	JAN1N5809US Bild	JAN1N5809US Aktie	JAN1N5809US Inventar
JAN1N5809US Neu	JAN1N5809US Original	JAN1N5809US garantiert	JAN1N5809US RFQ	JAN1N5809US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited